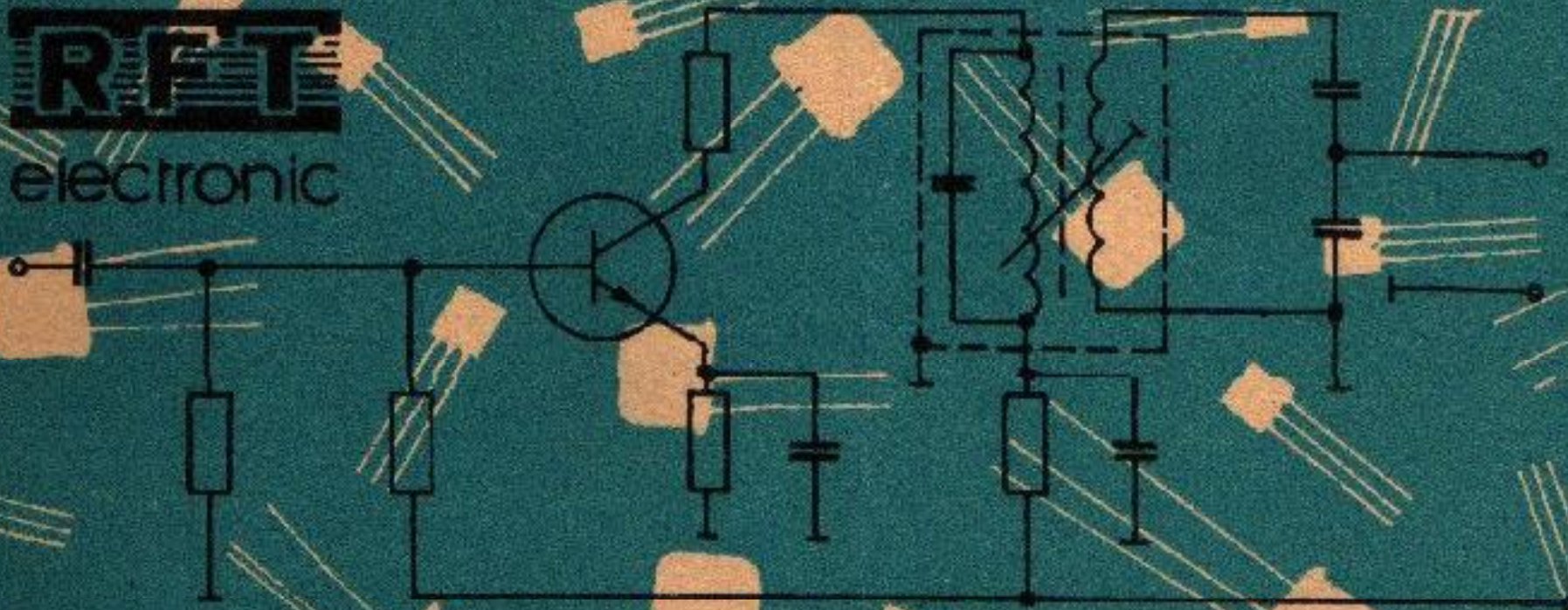


HALBLEITER

RFT
electronic

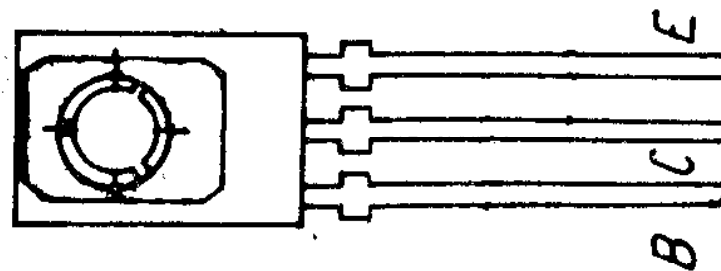


BASTLERBEUTEL 9

Inhalt

- a) 1 Stück Miniplasttransistor (für geregelte ZF-Stufen)
- b) 5 Stück Miniplasttransistoren (für unregelte ZF-Stufen)
- c) 4 Stück Miniplasttransistoren (für HF-Verstärker, Vor- und ZF-Stufen)
- d) 2 Stück Silizium-npn-Transistoren (für höhere Betriebsspannungen)

Anschlußschema:



- a) ohne Kennzeichnung
- b) 1 Farbpunkt
- c) 2 Farbpunkte

d)

d)

Daten der Transistoren

a), b), c)

Reststrom	$I_{CBO} \leq 500 \text{ nA}$	bei $U_{CB} = 20 \text{ V}$
Durchbruchsspannung	$U_{(BR)CEO} \geq 12 \text{ V}$	bei $I_C = 1 \text{ mA}$
Stromverstärkung	$h_{21E} \geq 5$	bei $U_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_C = 10 \text{ mA}$

d)

Reststrom	$I_{CBO} \leq 100 \text{ nA}$	bei $U_{CB} = 100 \text{ V}$
Reststrom	$I_{CER} \leq 5 \text{ mA}$	bei $U_{CER} = 100 \text{ V}$ $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$
Stromverstärkung	$h_{21E} \geq 8$	bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 5 \text{ mA}$

Hinweise

Die im Bastlerbeutel enthaltenen Miniplasttransistoren sind speziell für den Einsatz im geregelten und ungeregelten ZF-Verstärker für Frequenzen bis etwa 40 MHz vorgesehen.

Gute Ergebnisse kann man auch bei anderen Anwendungen bis 200 MHz erzielen:

- z. B.:
- Mischstufen
 - Breitbandverstärker für UKW
 - Treiberstufen für Transistorsender

Diese Transistoren sind in Ermitterschaltung einzusetzen.

Die unter d) ausgewiesenen Si-Transistoren können in Videoendstufen und Regelnetzteilen für höhere Spannungen eingesetzt werden.

Halbleiter – Bastlerbeutel – Sortiment

1 NF-Schaltungen

Inhalt: 14 NF-Transistoren

50–400 mW

2 HF-Schaltungen

Inhalt: 10 HF- und UKW-Transistoren

3 NF-Leistungstransistor-Schaltungen

Inhalt: 5 NF-Leistungstransistoren

1–10 W

4 Gleichrichterdiode

Inhalt: 12 Ge- bzw. Si-Gleichrichterdiode

0,1–1 A

5 Leistungsgleichrichterdiode

Inhalt: 4 Si-Leistungsgleichrichterdiode

10 A

6 Si-Miniplasttransistoren

Inhalt: 20 HF- und Schalttransistoren

200 mW

7 Si-Transistoren im Metallgehäuse

Inhalt: 12 HF- und Schalttransistoren

300–600 mW

8 Digitale Integrierte Schaltkreise

Inhalt: 8 Integrierte Schaltkreise für die Anwendung in der Digitaltechnik

12 Siliziumtransistoren für ZF- und HF Schaltungen

EVP: 7,55 Mark



VEB RÖHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS

im VEB Kombinat Mikroelektronik

6420 Neuhaus am Rennweg

Thomas-Mann-Straße 2

Telefon 50

48. Juli 1982